

# SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5961

SJ 20062—92

---

半导体分立器件  
3DG210 型 NPN 硅超高频低噪声  
差分对晶体管  
详细规范

Semiconductor discrete device  
Detail specification for silicon NPN  
ultra-high frequency low-noise difference  
match transistor of type 3DG210

1992-11-19 发布

1993-05-01 实施

---

中国电子工业总公司 批准

中华人民共和国电子行业军用标准

半导体分立器件  
3DG210 型 NPN 硅超高频低噪声差分对晶体管  
详细规范

SJ 20062—92

Semiconductor discrete device  
Detail specification for silicon NPN  
ultra-high frequency low-noise difference  
match transistor of type 3DG210

---

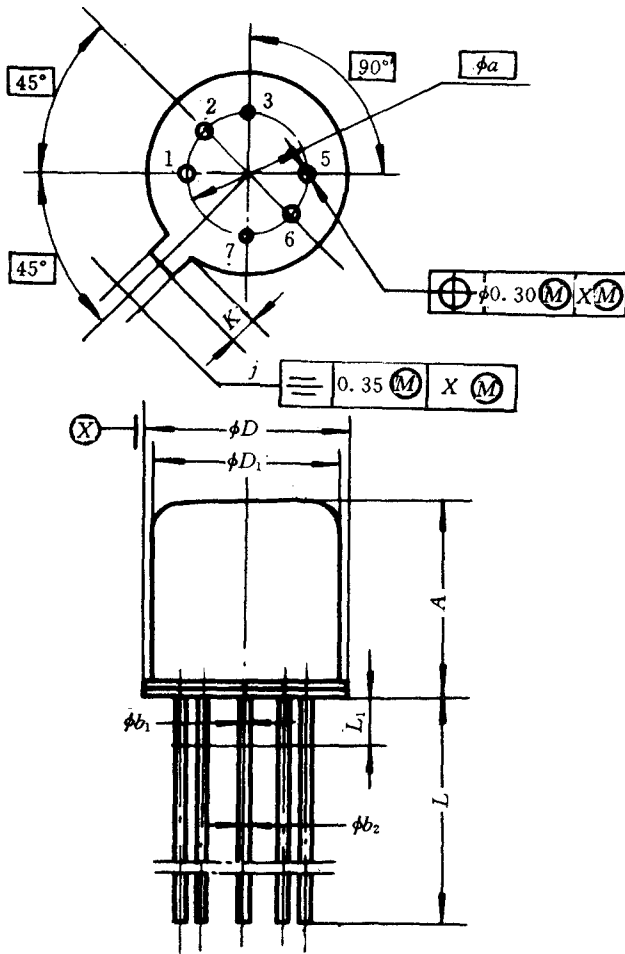
1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 3DG210 型 NPN 硅超高频低噪声差分对晶体管(以下简称器件)的详细要求。该种器件按 GJB 33《半导体分立器件总规范》的规定,提供产品保证的三个等级(GP、GT 和 GCT 级)。

1.2 外形尺寸

外形尺寸应符合 GB 7581《半导体分立器件外形尺寸》中的 A6-02A 型及如下规定,见图 1:



引出端极性:

- 1. 发射极 1
- 2. 基 极 1
- 3. 集电极 1
- 7. 发射极 2
- 6. 基 极 2
- 5. 集电极 2

mm

代号 尺 寸	A6-02A		
	最小	公称	最大
A	6.10		6.60
$\phi a$		5.08	
$\phi b_1$			1.01
$\phi b_2$	0.407		0.508
$\phi D$	8.64		9.39
$\phi D_1$	8.01		8.50
$j$	0.712	0.787	0.863
$K$	0.740		1.14
$L$	12.5		25.0
$L_1$			1.27

图 1 外形尺寸